

关键指标

频率：8~12GHz

均衡量：2dB

插入损耗：0.6dB@12GHz

芯片尺寸：0.8mm×0.7mm×0.1mm

产品简介

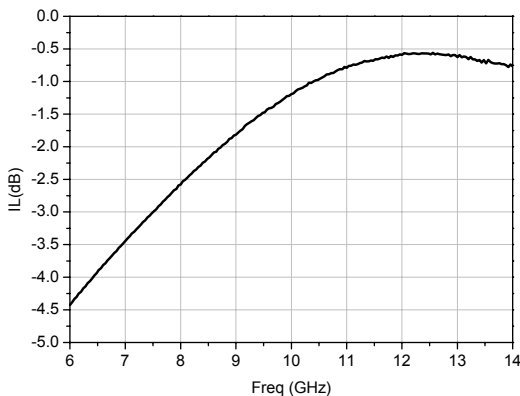
HG115JI 是一款 8~12GHz 均衡器芯片，采用 GaAs pHEMT 工艺制作，均衡量为 2dB，输入输出驻波比为 1.3/1.3。

电性能 (T_A=25°C)

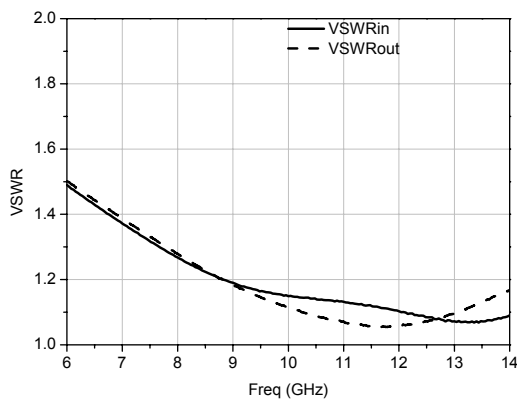
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	8~12		
输入驻波	-	-	1.3
输出驻波	-	-	1.3
插入损耗(dB)	-	0.6	-
均衡量(dB)	-	2	-

典型测试曲线

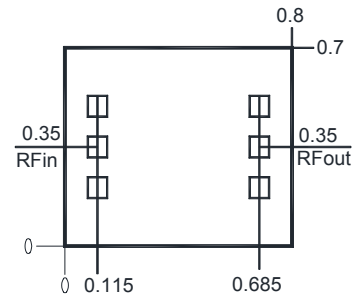
插入损耗



驻波



外形和端口尺寸 (mm)



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。